

## ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РЕКОМБИНИРУЮЩЕГО АНСАМБЛЯ ФЕРМИОНОВ

А.Н.Ораевский, Т.В.Саркисян, Д.К.Бенди\*<sup>1)</sup>

*Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН  
117924 Москва, Россия*

*\*Университет штата Оклахома  
74078 Стиллвотер, Оклахома, US*

Поступила в редакцию 6 сентября 1995 г.

После переработки 22 сентября 1995 г.

Показано, что температура рекомбинирующего статистически вырожденного ферми-ансамбля возрастает.

При анализе ряда проблем приходится сталкиваться с процессом излучательной рекомбинации частиц. Примерами таких процессов могут служить межзонная рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках или аннигиляция в системе, состоящей из частиц и античастиц. В связи с этим возникает вопрос: как ведет себя температура рекомбинирующего (аннигилирующего) ансамбля частиц? На первый взгляд кажется, что температура ансамбля должна уменьшаться за счет излучения фотонов<sup>2)</sup>. Однако ответ на этот вопрос не столь тривиален, как это может показаться, и требует более внимательного анализа: нужно иметь в виду, что в процессе рекомбинации происходит не только испускание фотонов, но и уменьшение плотности частиц в ансамбле.

В любой достаточно сложной системе наряду с рекомбинацией протекают и другие процессы. Да и сама рекомбинация может представлять собой комплексный процесс. Желая, однако, понять роль уменьшения плотности частиц, ограничимся простейшей моделью. Будем исследовать изолированный ансамбль ферми-частиц, из которого "исчезают" частицы со скоростью, зависящей от их энергии. Энергия каждой частицы  $E = E_g + \epsilon$  состоит из собственной энергии  $E_g$  и энергии теплового движения  $\epsilon$ . Будем считать, что тепловая энергия частицы значительно меньше собственной энергии частицы, так что в дальнейших расчетах можно пользоваться разложением в ряд по величине  $\epsilon/E_g$ .

Очевидно, что для описания исследуемого процесса необходимо два уравнения: для концентрации частиц и энергии ансамбля. Мы используем следующее уравнение для концентрации частиц  $n$ :

$$\frac{dn(\mu, T)}{dt} = - \int_0^{\infty} w(E) \rho(\epsilon) f(\epsilon, \mu, T) d\epsilon; \quad n(\mu, T) = \int_0^{\infty} \rho(\epsilon) f(\epsilon, \mu, T) d\epsilon, \quad (1)$$

где  $w(E)$  – вероятность спонтанной рекомбинации частиц с энергией  $E$ ,  $f(\epsilon, \mu, T)$  – их функция распределения,  $T$  – температура, а  $\mu$  – ферми-потенциал ансамбля;  $\rho(\epsilon)$  – плотность энергетических состояний. Вводя температуру рекомбинирующего ансамбля, мы предполагаем, что установление

<sup>1)</sup> D.K.Bandy

<sup>2)</sup> Наш личный опыт научных дискуссий показывает, что это наиболее расхожая точка зрения.

теплового равновесия в ансамбле происходит значительно быстрее, чем их рекомбинация.

Уравнение для плотности энергии ансамбля  $U(\mu, T)$  может быть написано, исходя из закона сохранения энергии. Каждая рекомбинирующая частица уносит с собой энергию  $E$ . Поэтому

$$\frac{dU(\mu, T)}{dt} = - \int_0^{\infty} w(E)(E_g + \epsilon)\rho(\epsilon)f(\epsilon, \mu, T)d\epsilon; \quad U(\mu, T) = \int_0^{\infty} (E_g + \epsilon)\rho(\epsilon)f(\epsilon, \mu, T)d\epsilon. \quad (2)$$

Теперь мы можем написать уравнение для изменения температуры ансамбля, которое и даст в конечном счете ответ на вопрос, поставленный в начале статьи. Пользуясь тем, что

$$\frac{dU(\mu, T)}{dt} = \frac{\partial U}{\partial n} \frac{dn}{dt} + \frac{\partial U}{\partial T} \frac{dT}{dt},$$

можно уравнение (2) переписать в виде

$$\frac{dT}{dt} = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)^{-1} \int_0^{\infty} w(E) \left( \frac{\partial U}{\partial n} - E_g - \epsilon \right) \rho(\epsilon) f(\epsilon, \mu, T) d\epsilon. \quad (3)$$

Чтобы раскрыть уравнение (3), нужно найти явное выражение  $U(\mu, T)$  и  $n(\mu, T)$  через ферми-потенциал и температуру и задать функцию  $w(E)$ . Для квадратичной зависимости энергии  $\epsilon$  от импульса поступательного движения  $\rho(\epsilon) = \epsilon^{1/2}$ . Будем считать состояние частиц статистически вырожденным, а функцию распределения – фермиевской.  $U(\mu, T)$  и  $n(\mu, T)$  могут быть вычислены по методике, рекомендованной в книге [1]. С точностью до членов второго порядка по температуре

$$n(\mu, T) = \left( \frac{\mu - E_g}{\alpha} \right)^{3/2} \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{\pi kT}{2(\mu - E_g)} \right)^2 \right], \quad \alpha = \left( \frac{6\pi^2}{g} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m}, \quad (4)$$

$$U(\mu, T) = n \left\{ E_g + \frac{3}{5}(\mu - E_g) \left[ 1 + 2 \left( \frac{\pi kT}{2(\mu - E_g)} \right)^2 \right] \right\}, \quad (5)$$

$g$  – статистический вес,  $m$  – масса частиц. Очевидно, что справедливость формул (4) и (5) требует малости величины  $kT/(\mu - E_g)$ .

Далее мы предположим, что

$$w(E) = \frac{1}{\tau_s} \left( \frac{E}{E_g} \right)^q, \quad (6)$$

где величина  $\tau_s$  не зависит от  $E$ . В основе этого предположения лежит тот факт, что вероятность спонтанной излучательной рекомбинации пропорциональна квадрату матричного элемента дипольного момента и кубу частоты излучаемого фотона [2]. Поэтому  $q = 3$ , если матричный элемент дипольного момента практически не зависит от частоты. В общем случае  $q \neq 3$ .

Соотношения (4)–(6) позволяют раскрыть уравнение (3). В общем виде оно громоздко, и мы выпишем его для температуры, близкой к нулевой, пренебрегая членами порядка  $(\mu - E_g)/E_g$  и более высокого порядка малости:

$$\frac{d\theta^2}{dt} = \frac{1}{\tau_s} (\mu - E_g)^2; \quad \theta = \frac{\pi}{2} kT. \quad (7)$$

Из этого уравнения следует, что производная от температуры по времени существенно положительна. Таким образом, рекомбинация приводит к разогреву вырожденного ферми-ансамбля.

Рассмотрим теперь ансамбль с невырожденной (больцмановской) статистикой, когда

$$U = n \left( E_g + \frac{3}{2} kT \right). \quad (8)$$

В этом случае (3) (с точностью до членов более высокого порядка по  $kT/E_g$ ) сводится к следующему уравнению:

$$\frac{d}{dt}(kT) = -q \frac{(kT)^2}{E_g}. \quad (9)$$

Видно, что изменение температуры невырожденного ансамбля существенно зависит от знака  $q$ . Температура уменьшается, если  $q > 0$ , увеличивается, если  $q < 0$ , и остается неизменной при  $q = 0$ . Это допускает простую интерпретацию. При  $q > 0$  скорость ухода более горячих частиц превышает скорость ухода более холодных, что приводит к охлаждению ансамбля. При  $q < 0$  мы имеем обратную ситуацию. При  $q = 0$  скорость ухода частиц не зависит от их энергии, и температура ансамбля остается неизменной. Как мы видим, в вырожденном случае рекомбинирующий ансамбль фермионов разогревается независимо от значения  $q$ . Причина такого поведения ансамбля в том, что вырожденный ферми-ансамбль состоит, в основном, из "холодных" частиц, энергия которых меньше ферми-потенциала.

Уравнения (7) и (9) получены в предельных случаях вырожденной и больцмановской статистик. В общем случае можно ожидать сложного динамического поведения температуры. Анализ в этом случае может быть проведен лишь численно и является предметом специального рассмотрения.

При воздействии на полупроводник короткого импульса излучения пикосекундной или фемтосекундной длительности, энергия кванта которого превосходит энергию запрещенной зоны, создается ансамбль носителей, температура которого может не совпадать с температурой решетки. В процессе установления стационарной температуры ансамбля эффект рекомбинационного разогрева (охлаждения) играет существенную роль. Поэтому он должен быть принят во внимание при анализе неравновесной температурной динамики в различных полупроводниковых приборах [3,4]. В частности, учет его важен для понимания процесса восстановления усиления в полупроводниковом усилителе после прохождения через него короткого импульса излучения [5].

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 92-23565), NSF (грант ECS-9215852), INTAS (грант 93-2633) и NATO (грант 921019).

- 
1. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, *Статистическая физика*, М.: Наука, 1964, стр. 192 - 194.
  2. А.Н.Ораевский, УФН 164, 415 (1994).
  3. J.Moerk, J.Mark, and C.P.Selzer, *Appl. Phys. Lett.* 64, 2206 (1994).
  4. A.V.Uskov, J.R.Karin, R.Nagarajan, and J.E.Bowers, *IEEE J. of Selected Topics in Quantum Electronics* 1, (2), 551 (1995).
  5. K.L.Hall, Y.Lai, and E.P.Ippen, *Appl. Phys. Lett.* 57, 2888 (1990).